⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-251214

@Int Cl.4

の出

願

識別記号

庁内整理番号

昭和63年(1988)10月18日 43公開

B 29 C 45/26 B 29 C B 29 L 33/38 17:00

6949-4F 8415-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁) 4F

公発明の名称 成形用金型

> の特 顖 昭62-86683

22出 願 昭62(1987) 4月8日

沢 廖 彦 73発 明 者 澙 昭和電工株式会社 長野県塩尻市大字宗賀1 昭和電工株式会社塩尻研究所内

東京都港区芝大門2丁目10番12号

外2名 弁理士 志賀 正武 の代 理 人

1. 発明の名称 成形用金型

2. 特許請求の顧問

(1)ロックウェル硬度(Aスケール)9 0以上のセ ラミックス製薄膜層がセラミックス製の基材に積 周されてなるセラミックス部材の薄膜層積層面に よって、少なくともキャピティ面の一部が形成さ れたことを特徴とする成形用金型。

(2)セラミックス部材の薄膜層が乾式コーティン グ法によって形成されたものであることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の成形用金型。

(3)セラミックス部材の基材および蒜膜層が、炭 化珪素からなるものであるごとを特徴とする特許 請求の範囲第1項および第2項記載の成形用金型。 (4)セラミックス製薄膜層の形成する面が表面粗 さり、02S~1、2Sであることを特徴とする 特許請求の範囲第1項ないし第3項記載の成形用 全型。

3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、コンパクトディスクやレーザーディ スクなどの光ディスクの成形又は精密部品等の成 形に好遺に用いられる金型に関するものである。

「従来の技術」

原音を高精度に再生できるオーディオレコード として、コンパクトディスクが提供されている。 このコンパクトディスクには、 数少なピット(凹 部)の有無によって信号が記録されている。この ような光ディスクの製造は、一般に、ピットに対 応する突起を有する薄い円板(スタンパ)を成形用 金型に取り付けて、射出成形法により行なわれる。

光ディスクの成形に用いられる成形用金型は、 第3図に示すように、固定側金型1のキャビティ 面laと可動側金型2のキャピティ面2aとで円板 状のキャビティるが形成されたもので、この金型 の可動側金型2のキャピティ面2aは鏡面に仕上 けられている。そして、このキャピティ面 2°aに は、中央の凹部4を利用して、スタンパ5が着脱 可能に取り付けられている。このスタンパ5は、 ディスクの種類に応じて逐次交換される。

従来、この種の成形用金型は、加工上の都合からスタバックス(商品名 ウッデホルム社製)などの類材によって製作されていた。

ところが、この成形用金型にあっては、キャビティ面 2 aが傷付き易い問題があった。キャビティ面 2 aが傷付くと、その傷のために薄いスタンパ 5 に変形が生じ、ついには成形されるデイスクに 伝写されて、不良品が大量に生産されてしまう問題がある。

このため従来は、キャビティ面 2 aに偽が付く と、その都度キャビティ面 2 aのメンテナンス (磨き直し)を行わなければならず、ディスクの生産 効率を向上するうえで障害となっていた。

このような問題に対処し得る成形用金型として、本発明者らは先に特願昭 6 1 - 2 3 5 9 4 号において、キャビティ 3 の一部をセラミックス焼結体で形成した成形用金型を提案した。第 4 図は、この成形用金型の一例を示すもので、スタンパ5 の

図った。

以下、図面を参照して本発明の成形用金型を詳しく説明する。

第1図は、本発明の成形用金型の一例を示すもので、上記従来例と同一構成部分には、同一符号を付して説明を簡略化する。

この例の成形用金型では、スタンパ5の取り付けられるキャビティ面2aがセラミックス部材 I 0 によって形成されている。

セラミックス部材10は、ドーナツ板状のもので、第2図に示すように基材10aと薄膜圏10bによって形成されている。セラミックス部材10の中央の孔10cはスタンパ取り付け用凹部4の一部をなしている。このセラミックス部材10の取り付けは接着剤を用いて行うこともできるが、この例の成形用金型のセラミックス部材10は固定や11によって可動側金型本体2bに映持固定されている。

このセラミックス彫材 1 0 の基材 1 0 aは、 設 温されるセラミックス製酵膜暦 1 0 bの無膨温率 取り付けられる可動倒金型2のキャビティ面2 a がセラミックス旋結体からなるセラミックス板6 によって形成されている。 この成形用金型によれば、金型メンテナンスの領度を大幅に減らすことができる利点がある。

しかしながら、一般にセラミックス焼結体から ポアーを完全に取り除くことは困難であるので、 セラミックス板6の表面には微細な孔が分布して おり、このためスタンパ5に薄目のものを用いる と、この孔が成形品に転写される恐れがあった。 このため、先に提案した成形用金型にあっては、 約0.3m以上の厚目のスタンパ5を用いなけれ ばならず、電鉄によって製造されるスタンパ5の 価格の高騰を招いていた。

「 関題点を解決するための手段 」

そこで本発明の成形用金型にあっては、ロックウェル硬度(Aスケール)9 0以上のセラミックス製 製薄膜層がセラミックス製の基材に積層されてなるセラミックス部材の薄膜層形成面でキャビティ面を形成することによって、上紀問題点の解決を

との差ができるだけ小となるように、セラミックスによって形成されている。この基材 1 0 mは、焼結密度が理論密度の 8 5 %以上(炭化珪素の場合は 2.74g/cm "以上ということになる)のセラミックス焼結体で形成されたものが適し、特に領ましくは理論密度の 9 3 %以上(炭化珪素の場合は 2.0 3g/cm "以上)である。焼結密度が小になると、セラミックス焼結体中のポアーが大型化するので、セラミックス解材 1 0 の表面を十分平滑に仕上げることができない不都合が生じる。

このセラミックス製の基材10aに機圏されるセラミックス製剤膜層10bは、セラミックス機構体中に存在するポアーによって形成される基材10aの表面の微細孔を塞ぐために設けられる層で、少なくともスタンパ5が取り付けられるキャビティ面2aを覆うように形成されている。この静膜層10bは、ロックウェル硬度(Aスケール)90以上のセラミックスによって形成されている。この静膜層10bの硬さが90未満であると、スタンパ5を取り待える際の治具などの衝突により、

また表面を清掃するときなどの摩擦により、セラミックス部材10の形成するキャビティ面2aに 傷が付きやすくなる不都合が生じる。

このセラミックス製剤膜層10bは、乾式コーティング法によって形成される。ここで乾式コーティング法とは、物理蒸着法(PVD法)や化学気相折出法(CVD法)等の、気相状態で薄膜を形成する技術を示す。PVD法としては、電子ピーム蒸着法等の真空蒸着法やスッパッタ法、イオンプレーティング法、モレキュラピームエピタクシー法などを挙げることができる。

このような手段によって形成される薄膜層 1 0 bの厚さは、5 0 ~ 2 0 0 μ m程度であることが望ましい。薄膜層 1 0 bの膜厚が 5 0 μ a以下になると、セラミックス焼結体中に存在するボアーによって形成される基材 1 0 aの表面の微細孔を塞ぐことができない場合がある。また、薄膜層 1 0 bの腹厚が 2 0 0 μ mを越えると、不経済である。

このような薄膜層 1 0 bおよび基材 1 0 aを形成するセラミックス材料には種々のものを利用でき

0の基材 1 0 aにはいずれの方法で製造された炭化珪素焼結体も利用できる。また、炭化珪素焼結体は、主成分である炭化珪素(SiC)の微粉末に炭素類(C)などを添加して、これを焼結させることで製造されるが、これらに更にSiCの焼結をより円滑に進行させるホウ素などを含む添加物(例えば、炭化ホウ素(BaC)等)を加えられたものがある。この発明の成形用金型には、いずれの炭化珪素焼結体をも利用できることは勿論である。

セラミックス部材 I 0 の薄膜層 I 0 bを 炭化珪素 素 膜 で 形成 する 場合、スパッタ 法 で は 炭化 住業 製のターゲットを用いる。また C V D 法 で、 炭化 珪素 可 原を 形成 するに は、 キャリアーガス として の水素に 四 塩化 は エ ア で 基 材 I 0 aを I 4 0 0 で 程 度 に 加 熱 することもできる。また、メチルクロッシンを 用いることのできる。また、 ガロッシンを 水素 と 少量のアルゴンに 混合してきる。 なん チャクロッシンを 水素 と 少量のアルゴンに 混合してきる。 また の場合は、 常圧下で 基材 I 0 aを I 2 0 0~1

利用できるセラミックス材料の具体例としては、 炭化珪素、塞化珪素、アルミナ、蜜化アルミ、ジ ルコニア、スピネル、チタンカーパイド、ポロン カーパイドなどを挙げることができる。

中でも、炭化珪素は、熱伝導率が大きいので、 成形時の冷却を円滑に行うことができ、成形時間 を短縮して成形サイクルの短縮を図ることができ る利点がある。

炭化珪素にはα型、β型などがあるが、このセラミックス部材 1 0 をなすセラミックス材料には、いずれも用いることができる。炭化珪素の焼結法として、加圧焼結する方法と、無加圧で焼結する方法と、珪素(Si)と炭素(C)を反応させながら 焼結する方法があるが、このセラミックス部材 1

500℃程度に加熱する。

このような炭化珪素からなるセラミックス部材 1 0 を製作するには、通常はまず、炭化珪素に結 合剤及び助剤を所定量添加しさらに水を所定量加 えた後、ボールミル等でそれらを十分混合してス ラリーを作る。ついで、このスラリーをスプレー ドライヤー等で処理して顆粒化した後、この駅 をプレス等で加圧成形し、成形体を作る。次いで、 この成形体を、炭盤などで所定の 状に加工した後焼結し、所定の面に研摩加工等を 焦し、 蓋材 1 0 aを製作する。

次ぎに、この基材10aの研摩された面にCV D法等により炭化珪素をコーティングし、ついで その面にダイヤラップによる磨き等の仕上げ加工 を施し薄膜層10bとして、セラミックス部材1 0を完成する。

キャピティ面 2 aを形成するセラミックス部材 1 0 の神鏡暦 1 0 bの表面組さは、0.02S~ 1.2 S 程度であることが望ましい。

薄膜周10bの形成された面は、セラミックス

このようなセラミックス部材 1 0 が取り付けられた成形用金型の固定側金型 1 ・可動側金型 2 には、成形時の金型を所定温度に維持するための冷却孔 1 2 … がそれぞれ設けられている。

「作用」

5 が変形することも無いので、そのままディスク の生産を執続してもなんら関風は生じない。

また、このセラミックス部材10は、セラミックス製薄膜層10 bによってその表面が形成されているので、セラミックス焼結体中に存在するポアーによって形成された基材10 aの表面の数細孔が塞がれている。従って、このセラミックス部材10の形成するキャビティ面2 aには、薄手のスタンパ5を取り付けても、成形品に基材10 a のポアーに起因する異常は生じない。

「実施例」

第1図に示した成形用金型を作成した。まず、スタバックスを用いて、可動側金型本体 2 bと固定側金型 1 を製作した。次ぎに、炭化珪素によって外径140mm、内径34mm、厚さ12.7mmのドーナツ盤状のセラミックス焼結体を作成してセラミックス部材 1 0 の基材 1 0 aとした。次いで、この基材 1 0 aを C V D 装置を減圧した後、基材 1 0 aを 1 4 0 0 ℃に加熱し、次いで装置に四塩化珪素 - プロバンガスからなる

このような構成の成形用金型にあっては、スタンパ5を交換する際、可動倒金型2のキャピティ面2aに治具などが当たっても、成形されるディスクに転写されるような損傷が生じることはない。その理由を、本発明者は次ぎのように考察している。

まず、この全型のキャビティ面2aはセラミックス部材10で形成されているので、治具などが当たっても傷が付き難い。また、傷が付いてもその傷は強いものとなる。

しかも、セラミックスは金属材料と異なりもろい材料なので、キャピティ面2aに損傷を受けても、鋼材のように塑性変形して傷の周囲が盛り上がるようなことはない。従って、従来の鋼材からなる全型の場合にはこの盛り上がった部分に接するスタンパ5の一部分に成形圧力が集中してそこに変形が生じたが、セラミックス部材を用いた本発明の全型では、キャピティ面2aに傷が付いても盛り上がりは生じない。従って、スタンパ5の一部に成形圧力が集中することが無く、スタンパ

混合ガスをキャリアガスとしての水煮に混合して 供給して、基材 1 0 aの一方の面に 膜厚 1 4 0 μ z の炭化珪素製薄膜層 1 0 bを形成し、セラミック ス部材 1 0 を得た。

次ぎに、このセラミックス部材10を、可動倒 金型本体2bの所定位限に固定枠11を用いて固 定した。この後、セラミックス部材10の表面を 研削加工しついでダイヤラップ加工して、表面租 さ0.2S、平行度0.002、平面度0.003に仕上げた。 この成形用金型を使用に供して、その効果を確 認した。

まず、この成形用金型を射出成形機に取り付けた後、薄手のスタンパ 5 (厚さ 0.1 mm)をセットして、外径 120 mm、内径 15 mm、厚さ 1.2 mmのレーザーディスクを 1 0 0 0 枚連続成形した。成形は、80 ℃の温水を冷却孔 1 2 … に通し、300℃の溶散ポリカーボネイト樹脂をキャビティ 3 に注入して行った。

成形後、成形品とスタンパ5を調べたところ、 成形品、スタンパ5共に全く異常は見られず、こ の成形用金型によれば、 0 . 1 mmというような薄いスタンパ 5 を用いてもディスクを問題なく生産できることが判明した。

なお、上紀実施例にあっては、キャビティ3を 形成するキャビティ面1a.2aのうち一郎(面2a) のみをセラミックス部材10で形成したが、全キャ ビティ面をセラミックス部材10で形成して6良 いことは勿論である。

また、実態例の成形用金型にあっては、冷却孔 12…を可動側金型本体2bに設けたが、セラミッ

5.

また、本発明の成形用金型に用いられるセラミックな製御機関に出いっクス製御機関になる。というこのでは、整備には、を動物に変している。というというというでは、本発明の成形のでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないできる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の成形用金型の一実施例を示す 断面図、第2図は同実施例のA部拡大図、第3図 従来の成形用金型を示す断面図、第4図は先に提 案した成形用金型を示す断面図である。 クス部材 1 0 に冷却孔 1 2 …を設けることもできる。この場合、セラミックス部材 1 0 の固定は、金型本体 2 bに固定用インローを設けこれにセラミックス部材 1 0 を係止するなどの手段を取ることが望ましい。セラミックス部材 1 0 に冷却孔を設けると、キャピティ面 2 aの冷却がより円滑に行えるので、セラミックス部材 1 0 を形成するセラミックスに無伝導率の多少劣るものでも利用できる利点が有る。

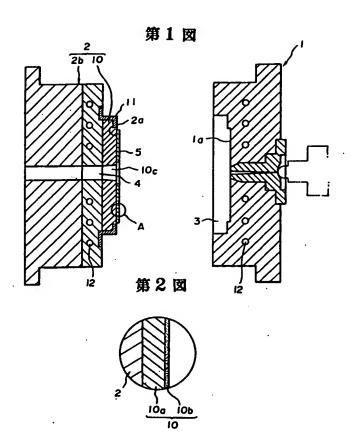
「発明の効果」

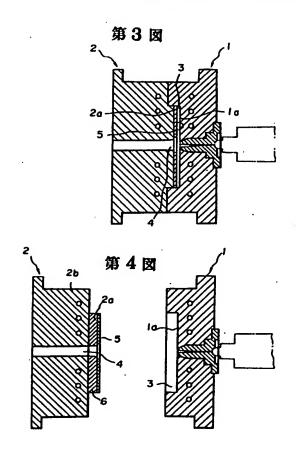
以上説明したように、本発明の成形用金型は、キャビティをなすキャビティ面の少なくとも一部をセラミックス郎材で形成したものなので、光ディスク等の成形に用いた場合など、スタンパ交換時に治臭が衝突しても損傷を受け難く、金型メンテンスの頻度を大幅に減らすことができる。従って、本発明の成形用金型は、取り扱いが容易で、全型管理の労力の軽減、全型の使用効率の向上を図ることができ、よってディスクの生産効率のにあるなど、優れた利点を有するものであ

2 a… キャビティ面、10…セラミックス部材、 10 a… 基材、10b… 部膜層。

出願人 昭和電工株式会社

特開昭63-251214(6)





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-251214

(43) Date of publication of application: 18.10.1988

(51)Int.Cl.

B29C 45/26 // B29C 33/38

B29L 17:00

(21)Application number : 62-086683

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing:

08.04.1987

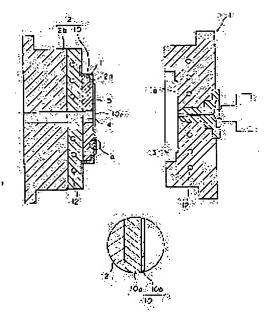
(72)Inventor: YUZAWA YOSHIHIKO

(54) MOLDING MOLD

(57) Abstract:

PURPOSE: To contrive improvement in working efficiency by reducing damage on a forming surface of a cavity of a molding mold, by forming a specific ceramic layer on a part forming the cavity of the molding mold.

CONSTITUTION: A cavity surface 2a of a mold is formed of a ceramic member 10. The surface of the ceramic member 10 is coated further with a film layer 10b made of ceramic. Therefore, even if a fine hole is formed on the surface of a base material 10a due to a pore existing within a sintered body of the ceramics, the fine hole is clogged with the film layer 10b and a smooth surface is always obtained. At the time of exchange of stampers, damage is little even if a jig collides with the surface. Frequency of maintenance work of the mold can be reduced drastically.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]